

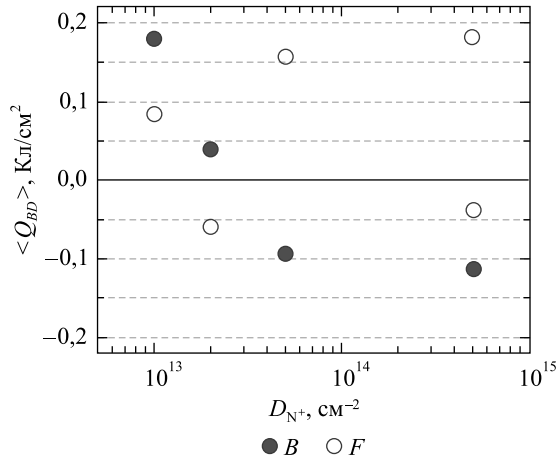


Рис. 3. Дозовая зависимость отклонения средней величины заряда пробоя для образцов, имплантированных N^+ , от аналогичной величины для контрольных образцов при обратном (B) и прямом (F) порядке термообработки.

Энергия имплантации для доз $1 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{14}$ см⁻² – 20 кэВ, для дозы $2 \cdot 10^{13}$ см⁻² – 40 кэВ

Fig. 3. Dose dependence of the average charge to breakdown deviation for samples implanted by N^+ from the same value for control samples in the reverse (B) and forward (F) heat treatment order.

Implantation energy for doses of $1 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{13}$; $5 \cdot 10^{14}$ cm⁻² – 20 keV, for a dose of $2 \cdot 10^{13}$ cm⁻² – 40 keV